

Содержание

● Атомная структура и неэлектронные свойства полупроводников

Кузнецов В.А.

Анализ фазовых диаграмм системы CdS—CdSe—CdTe . . . 1153

● Электронные и оптические свойства полупроводников

Агеева Н.Н., Бронева И.Л., Забегаев Д.Н., Кривоносов А.Н.

Субгерагерцовые автоколебания обеднения заселенностей электронов в зоне проводимости GaAs при наличии накачки и собственного стимулированного излучения 1157

Степанов Н.П., Калашников А.А.

Особенности спектров отражения монокристаллов твердых растворов Bi_2Te_3 — Sb_2Te_3 в области плазменных эффектов 1165

Емельянов А.М.

Дифференциальный метод анализа спектров люминесценции полупроводников 1170

Самсоненко С.Н., Самсоненко Н.Д., Тимченко В.И.

Дислокационная электрическая проводимость пластически деформированных природных алмазов 1176

Бахадырханов М.К., Аюпов К.С., Мавлонов Г.Х., Исамов С.Б.

Отрицательное магнитосопротивление в кремнии с комплексами атомов марганца $[\text{Mn}]_4$ 1181

Зейналов С.А., Алиев Ф.Ф., Дамирова С.З., Таиров Б.А.

Закон дисперсии и механизм рассеяния носителей заряда в p - $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{Sb}$, легированных Zn 1185

Давидюк Г.Е., Богданюк Н.С., Божко В.В., Кевшин А.Г., Манжара В.С., Кажукаускас В.

Влияние дефектов, образованных быстрыми реакторными нейтронами, на экситонные спектры люминесценции монокристаллов сульфида кадмия 1189

Брудный В.Н., Кособуцкий А.В., Саркисов С.Ю.

Уровень локальной электронейтральности и электронные свойства GaSe под давлением 1194

Махний В.П., Косолюцкий В.В., Слётов М.М., Скрипник Н.В., Слётов А.М.

Природа краевой люминесценции диффузионных слоев CdTe:Mg 1203

Соболев В.В., Антонов Е.А., Соболев В. Вал.

Непрямые межзонные переходы графита с большой энергией квазищели 1206

● Полупроводниковые структуры, границы раздела и поверхность

Катеринчук В.Н., Ковалюк М.З.

Пленки вырожденных собственных окислов полупроводниковых кристаллов InSe и In_4Se_3 1212

Машуков Ю.П., Михайлов Н.Н., Васильев В.В.

Электрические характеристики структуры CdTe— n -CdHgTe, полученной в едином процессе молекулярно-лучевой эпитаксии 1216

Гаджиалиев М.М., Пирмагомедов З.Ш., Эфендиева Т.Н.

Исследование гетероперехода p -Ge— n -GaAs при всестороннем давлении 1222

Венгер Е.Ф., Кириллова С.И., Корсунская Н.Е., Старая Т.Р., Хоменкова Л.Ю., Саченко А.В., Goidstein Y., Savir E., Jedrzejewski J.

Исследование границы раздела слой—подложка в структурах Si— SiO_2 — p -Si с кремниевыми квантовыми точками методом температурных зависимостей фотоэдс 1224

Романов Р.И., Зуев В.В., Фоминский В.Ю., Демин М.В., Григорьев В.В.

Электрофизические характеристики тонкопленочных структур, созданных импульсным лазерным осаждением металлов Au, Ag, Cu, Pd, Pt, W, Zr на кристалл n -6H-SiC 1229

● Низкоразмерные системы

Стрельчук В.В., Кладько В.П., Авраменко Е.А., Коломыс А.Ф., Сафрюк Н.В., Конакова Р.В., Явич Б.С., Валах М.Я., Мачулин В.Ф., Беляев А.Е.

Рентгеновская дифрактометрия и сканирующая микрорамановская спектроскопия неоднородностей структуры и деформаций по глубине многослойной гетероструктуры InGaN/GaN 1236

Белоненко М.Б., Глазов С.Ю., Мещерякова Н.Е.

Влияние переменного электрического поля на проводимость однослойных углеродных нанотрубок полупроводникового типа 1248

Грузинцев А.Н., Емельченко Г.А., Редькин А.Н., Волков В.Т., Якимов Е.Е., Висимберга Д. (Visimberga G.)

Зависимость порога лазерной генерации наностержней ZnO от их длины 1254

Чалдышев В.В., Шолохов Д.Е., Васильев А.П.

Резонансная брэгговская структура $(\text{AlGaAs}/\text{GaAs}/\text{AlGaAs})_{60}$ на основе второго уровня размерного квантования экситонов с тяжелыми дырками в квантовых ямах 1260

- **Аморфные, стеклообразные, пористые, органические, микрокристаллические полупроводники, полупроводниковые композиты**

Калыгина В.М., Зарубин А.Н., Новиков В.А., Петрова Ю.С., Скакунов М.С., Толбанов О.П., Тяжев А.В., Яскевич Т.М.

Влияние кислородной плазмы на свойства пленок оксида тантала 1266

- **Физика полупроводниковых приборов**

Грузинцев А.Н., Емельченко Г.А., Редькин А.Н., Волков В.Т., Якимов Е.Е., Висимберга Д. (Visimberga G.)

Модовая структура излучения лазеров из наностержней ZnO с одним металлическим зеркалом 1274

Якимов Е.Б., Соболев Н.А.

Исследование безызлучательной рекомбинации в кремниевых светодиодах с краевой люминесценцией методом наведенного тока (EBIC) 1280

Власов А.С., Хвостиков В.П., Сорокина С.В., Потопович Н.А., Калиновский В.С., Ракова Е.П., Андреев В.М., Бобыль А.В., Терещенко Г.Ф.

Газовый термофотоэлектрический генератор на основе металлических эмиттеров и GaSb-элементов 1284

Вишняков А.В., Ефремов М.Д.

Моделирование проводимости a -Si:H тонкопленочного транзистора с барьерами Шоттки 1290